



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**H 2222A**

对应国外型号  
MPS2222A

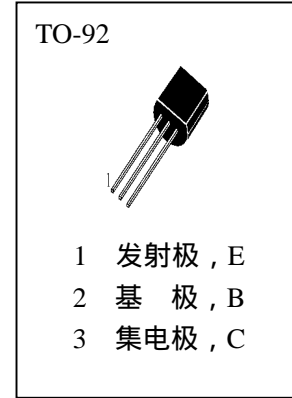
### 主要用途

作音频功率放大，激励级放大、开关应用

### 极限值 ( $T_a=25$ )

$T_{stg}$	——贮存温度.....	-55~150
$T_j$	——结温.....	150
$P_C$	——集电极耗散功率.....	625mW
$V_{CBO}$	——集电极—基极电压.....	75V
$V_{CEO}$	——集电极—发射极电压.....	40V
$V_{EBO}$	——发射极—基极电压.....	6V
$I_C$	——集电极电流.....	600mA

### 外形图及引脚排列



### 电参数 ( $T_a=25$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	75			V	$I_C=10\mu A, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	40			V	$I_C=10mA, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=10\mu A, I_C=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			10	nA	$V_{CB}=60V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			10	nA	$V_{EB}=3V, I_C=0$
$H_{FE}$	直流电流增益	100		400		$V_{CE}=10V, I_C=150mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.3	V	$I_C=150mA, I_B=15mA$
$f_T$	特征频率	300			MHZ	$V_{CE}=20V, I_C=20mA$
$C_{ob}$	共基极输出电容			8	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f=1MHz$